Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0304U001686

Державний реєстраційний номер: 0103U003082

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 16-03-2004

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Вивчити процеси іоно-плазмового низькотемпературного осадження плівок SiC з різними структурними станами та встановити зв'язок між умовами осадження SiC плівок та їх структурним станом і властивостями

Початок етапу: 01.2003

Закінчення етапу: 12.2003

Вид звітного документа: Без звіту

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): НДВ "Оптичні та конструкційні кристали" НТК "Інститут монокристалів"

Код за ЄДРПОУ: 23756545

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 32-82-30

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження процесів низькотемпературного утворення , модифікації та властивостей нанокристалічних плівок на основі карбіду кремнію

Назва роботи англійською:

Investigation of the processes of low temperature formation, modification and properties of nanocrystalline films on the basis of silicon carbide

Реферат українською:

Визначени умови одержання плівок SiC з різними структурними станами у діапазоні від аморфного до кристалічного. Визначени плівки нанокристалічного SiC з розмірами кристалів 15-100 нм.

Реферат англійською:

Stablished are the conditions of the obtaining of SiC films with different structure states in the range from amorphorcs to crystalline state.obtained are nanocrystalline SiC films with 15-100 nm crystal size.5635

Індекс УДК: 548:537.621;538.955-405;539.21:537.621, 548.55:539.216:546.28'26

Коди тематичних рубрик: 29.19.37

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Семенов О.В.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Пузіков В.М.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

